

2SB750, 2SB750A

シリコン PNP エピタキシャルプレーナ形ダーリントン
Si PNP Epitaxial Planar Darlington

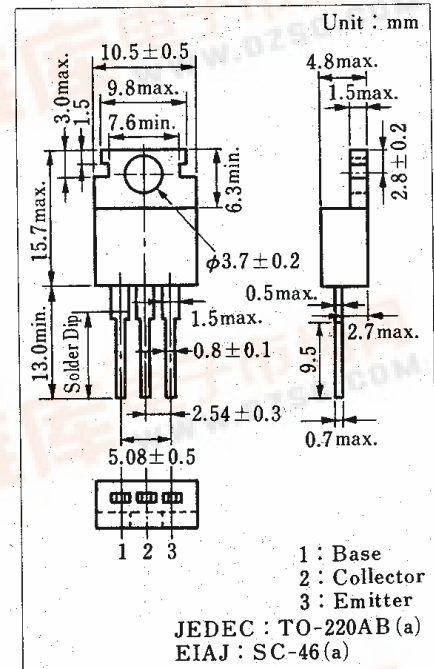
電力増幅用, スイッチング用 / Power Amplifier, Switching
2SD836, 2SD836A とコンプリメンタリ / Complementary Pair
with 2SD836, 2SD836A

■ 特徴 / Features

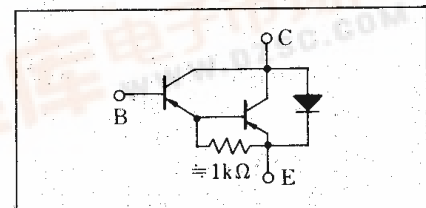
- 直流電流増幅率 h_{FE} が高い。 / High h_{FE}
- スイッチング速度が速い。 / High speed switching

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ C$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CB0}	-60	V
2SB750A		-80	
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	-60	V
2SB750A		-80	
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	-5	V
せん頭コレクタ電流	I_{CP}	-4	A
コレクタ電流	I_C	-2	A
コレクタ損失 ($T_c = 25^\circ C$)	P_C	35	W
接合部温度	T_j	150	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	$^\circ C$



内部接続図 / Connection Diagram



■ 電気的特性 / Electrical Characteristics ($T_c = 25^\circ C$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ シャ断電流	2SB750	$V_{CB} = -60V, I_E = 0$			-1	mA
	2SB750A	$V_{CB} = -80V, I_E = 0$			-1	
コレクタ シャ断電流	2SB750	$V_{CB} = -30V, I_B = 0$			-2	mA
	2SB750A	$V_{CB} = -40V, I_B = 0$			-2	
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -5V, I_C = 0$			-2	mA
コレクタ・ エミッタ電圧	2SB750	$I_C = -30mA, I_B = 0$	-60			V
	2SB750A	$I_C = -30mA, I_B = 0$	-80			V
直流電流増幅率	h_{FE1}	$V_{CE} = -4V, I_C = -1A$	1000			
	h_{FE2}^*	$V_{CE} = -4V, I_C = -2A$	1000		10000	
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	$V_{CE} = -4V, I_C = -2A$			-2.8	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -2A, I_B = -8mA$			-2.5	V
ターンオン時間	t_{on}	$I_C = -2A, I_{B1} = -8mA, I_{B2} = 8mA$		0.2		μs
ターンオフ時間	t_{off}			2		μs

